

2SC892

NPN エピタキシアル形シリコントランジスタ / NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR

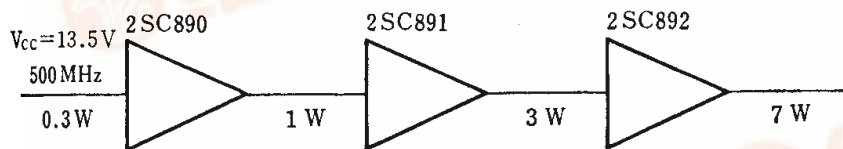
高周波電力増幅用 / High Frequency Power Amplifier

通信工業用／Industrial Use

特 徵 / FEATURES

- ・400MHz 帯で高出力が得られます。 $P_o=8.0W$ TYP.
($V_{CC}=13.5V$, $P_i=3.0W$, $f=500MHz$)
- ・低い電源電圧でも動作するため、車載無線機用として最適です。
実用電源電圧 9 ~ 18V
- ・フラットパッケージであるため、プリント配線とのマッチングがよい。
- ・エミッタ電極がスタッドに接続されているため動作が安定です。
- ・スタッド構造のため放熱設計が容易です。
- ・ $P_o=8.0W$ TYP. @ $V_{CC}=13.5V$, $P_i=3.0W$, $f=500MHz$.
- ・Suitable for mobile radio equipment operating at 9 to 18 volts.

Typical Lineup



绝对最大定格 / ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	40	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	20	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	4.0	V
コレクタ電流（直流）	$I_{C(DC)}$	1.2	A
コレクタ電流（ピーク）	$I_{C(peak)}$	4.0	A
全損失	$P_T(T_C=25^{\circ}C)$	17.7	W
熱抵抗	$R_{th(j-c)}$	8.5	$^{\circ}C/W$
ジャンクション温度	T_j	175	$^{\circ}C$
保存温度	T_{stg}	-40~+175	$^{\circ}C$

電氣的特性/ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=20V, I_E=0$			10	μA
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE}=10V, I_C=1.0A^*$	15			
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE}=10V, I_E=-300mA$	400			MHz
コレクション容量	C_{ob}	$V_{CB}=10V, I_E=0, f=1.0MHz$			26	pF
出力電力	P_o	$V_{CC}=13.5V, P_I=3.0W, f=500MHz$ See test circuit	7.0	8.0		W

外形図/PACKAGE DIMENSIONS
(Unit:mm)

